

AP935925USA7

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年12月26日

出願番号

Application Number:

特願2002-375978

[ST.10/C]:

[JP2002-375978]

出願人

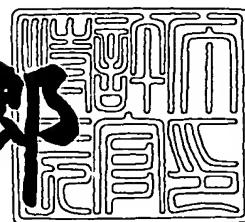
Applicant(s):

株式会社東芝

2003年 6月24日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3049432

【書類名】 特許願
 【整理番号】 APB01Z1431
 【あて先】 特許庁長官殿
 【国際特許分類】 H01L 21/266
 【発明の名称】 半導体装置の製造方法及び半導体製造装置
 【請求項の数】 16

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝
 横浜事業所内

【氏名】 柴田 武

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝
 横浜事業所内

【氏名】 須黒 恭一

【特許出願人】

【識別番号】 000003078
 【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】 100083161

【弁理士】

【氏名又は名称】 外川 英明

【電話番号】 (03)3457-2512

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010261
 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

特2002-375978

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置の製造方法及び半導体製造装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

薄膜部及び前記薄膜部を支持する支持部を有するステンシルマスクに粒子ビームを照射し、前記ステンシルマスクの前記薄膜部に形成された開口部を介して、被処理基板に前記粒子ビームを照射する半導体製造装置において、前記ステンシルマスクに照射される、前記粒子ビームの照射領域の端部が、前記ステンシルマスクの前記薄膜部上に存在しないよう、粒子ビームの照射領域を調整することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2】

前記照射領域の調整は、照射される粒子ビームの一部を遮蔽するアーチャーを介して、前記ステンシルマスクに粒子ビームを照射することによって行うことを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

前記照射領域の調整は、前記ステンシルマスクの前記薄膜部または前記支持部の位置を測定するマスク測定装置を用いて測定された情報を、粒子ビームを放射する粒子源、粒子ビームの放射領域の調整をするスキャナー及び照射される粒子ビームの一部を遮蔽するアーチャーの少なくとも 1 つに、フィードバックすることによって行うことを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

前記ステンシルマスクは、前記薄膜部を支持する梁構造部をさらに有することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 5】

前記粒子ビームの照射領域が、前記ステンシルマスクの前記支持部上に存在するよう、前記粒子ビームを照射することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 6】

前記粒子ビームの照射領域の端部が、前記ステンシルマスクの前記梁構造部または前記支持部上に存在するよう、前記粒子ビームを照射することを特徴とする請求項4に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項7】

前記ステンシルマスクの前記薄膜部に照射される、前記粒子ビームの照射は、ほぼ均一に行われることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項8】

前記ステンシルマスクに対して対向して配置された半導体基板に、前記ステンシルマスクの前記薄膜部に形成された前記開口部を介して照射される、前記粒子ビームの照射量が、前記ステンシルマスクの前記薄膜部の表面方向に対して、前記ステンシルマスクの前記薄膜部の所定の深さにおいて、一定であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項9】

薄膜部及び前記薄膜部を支持する支持部を有するステンシルマスクに粒子ビームを照射し、前記ステンシルマスクの前記薄膜部に形成された開口部を介して、被処理基板に前記粒子ビームを照射する半導体製造装置において、前記ステンシルマスクに照射される、前記粒子ビームの照射領域の端部が、前記ステンシルマスクの前記薄膜部上に存在するよう、前記粒子ビームを照射し、前記粒子ビームの照射量が少ない領域に対して、粒子ビームの照射、熱処理、薬液処理のうち、少なくとも1つ以上の処理をさらに行うことの特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項10】

前記ステンシルマスクは、前記薄膜部の一部上に前記支持部が積層されることによって構成されており、前記被処理基板に対向する面の前記薄膜部には、位置合わせマークが形成されていることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項11】

前記位置合わせマークは、前記薄膜部に形成された溝、または開口部であるこ

とを特徴とする請求項10に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項12】

前記アーチャーが、複数設けられていることを特徴とする請求項2に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項13】

前記マスク測定装置は、レーザー変位計を含むことを特徴とする請求項3に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項14】

前記マスク測定装置は、画像認識によって、前記ステンシルマスクの前記薄膜部または前記支持部の位置を測定する装置であることを特徴とする請求項3に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項15】

薄膜部及び前記薄膜部を支持する支持部を有するステンシルマスクに、粒子源及びスキャナーから粒子ビームを照射し、前記ステンシルマスクの前記薄膜部に形成された開口部を介して、被処理基板に前記粒子ビームを照射する半導体製造装置において、

前記ステンシルマスクの前記薄膜部または前記支持部の位置を測定するマスク測定装置と、

前記マスク測定装置で測定された情報を演算する演算器とを具備し、

前記演算器を用いて、前記情報を前記粒子源及び前記スキャナーの少なくともいずれか一方にフィードバックすることによって、粒子ビームの照射領域を調整し、前記粒子ビームの照射を行うことを特徴とする半導体製造装置。

【請求項16】

薄膜部及び前記薄膜部を支持する支持部を有するステンシルマスクに、粒子源及びスキャナーから粒子ビームを照射し、照射される粒子ビームの一部を遮蔽するアーチャーを介して、前記ステンシルマスクの前記薄膜部に形成された開口部に照射し、前記開口部を介して、被処理基板に前記粒子ビームを照射する半導体製造装置において、

前記ステンシルマスクの前記薄膜部または前記支持部の位置を測定するマスク測

定装置と、

前記マスク測定装置で測定された情報を演算する演算器とを具備し、

前記演算器を用いて、前記情報を前記粒子源、前記スキャナー及び前記アーチャーの少なくともいずれか一つにフィードバックすることによって、粒子ビームの照射領域を調整し、前記粒子ビームの照射を行うことを特徴とする半導体製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、転写用マスクとして例えばステンシルマスクを用いた半導体装置の製造方法及び半導体製造装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

半導体装置の製造工程において、所定のパターンを有するステンシルマスクを、被処理基板上に一定の距離を置いて設置し、ステンシルマスクのパターン開口部を通して、被処理基板に粒子ビーム（電子やイオンなどの荷電粒子ビーム、原子や分子、中性子などの中性粒子ビーム、光やX線などの電磁波ビーム）を照射する方法がある。

【0003】

例えば、図15に示すように、半導体製造工程におけるイオン注入工程にステンシルマスク120を用いる場合、被処理基板（図示しない）の所定のイオン注入領域上に開口部を有するステンシルマスク120を用いて行われる。すなわち、イオン注入領域には、ステンシルマスクのパターン開口部121が形成されており、パターン開口部121を通してイオンが注入され、非注入領域では、ステンシルマスクの遮蔽部（非開口部）によって、イオンが遮蔽される。ステンシルマスク120は、シリコン薄膜122からなる薄膜部123と、シリコン酸化膜124及びシリコン支持基板125からなる支持部126によって構成されている。ステンシルマスクのパターン開口部121は、イオンなどの粒子ビームの照射領域L₉内に形成されている。（例えば、特許文献1）図16（a）乃至図1

6 (c) に、図15に示した半導体製造装置の平面図を示す。

【0004】

また、図17に従来の技術の半導体製造装置の概略図を示す。図17に示すように、粒子源131からイオンなどの荷電粒子ビームを放射し、スキャナー132を用いて、放射領域の調整を行う。続いてスキャナー132からコリメータ133に粒子ビームを入射し、ステンシルマスク130に粒子ビームを照射している。ステンシルマスクは、所定のパターンを有しており、被処理基板134上に一定の距離を置いて設置されている。ステンシルマスクのパターン開口部を通して粒子ビームを被処理基板134に照射し、被処理基板134に対して、所定の処理を行う。

【0005】

【特許文献1】

特開2002-203806号公報（図3）

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

ステンシルマスクを繰り返し使用すると、遮蔽する粒子ビームの衝突が繰り返され、ステンシルマスクに、組成変化や構造変化などのダメージが蓄積する。図18 (a) に示すように、ステンシルマスクの薄膜部123は、ステンシルマスクのパターン開口部が形成されている領域よりも大きく形成されており、ステンシルマスクの薄膜部123において、粒子ビームが照射された領域と、非照射領域とが存在している。粒子ビームが照射されたステンシルマスクの薄膜部123における粒子ビームの照射領域 L_g には、ダメージ141が蓄積する。ステンシルマスクの連続した薄膜部123において、ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の境界領域に、大きなストレスがかかり、不連続な領域142となるため、図18 (b) に示すように、ステンシルマスクが変形したり、さらに、図18 (c) に示すように、ステンシルマスクが破損してしまうという問題があった。

【0007】

また、粒子ビームが照射されている、薄膜部の一部の領域における粒子ビームの照射量が不均一な場合にも、ダメージが蓄積しやすい領域と蓄積しにくい領域

の境界領域にストレスがかかり、不連続な領域となるため、ステンシルマスクが変形したり、破損してしまうという問題があった。

【0008】

なお、ステンシルマスクが変形すると、ステンシルマスクのパターン開口部の位置が変位し、被処理基板の所定の領域に、粒子ビームを照射することができない。その結果、製造した半導体装置の電気的特性がばらついたり、不良品が生じる。また、ステンシルマスクが破損すると、ステンシルマスクが使用不能となる。

【0009】

本発明は、上記した問題点を解決するためになされたもので、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することが可能な半導体装置の製造方法及び半導体製造装置を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

上記した目的を達成するための本発明の半導体装置の製造方法の一形態は、薄膜部及び前記薄膜部を支持する支持部を有するステンシルマスクに粒子ビームを照射し、前記ステンシルマスクの前記薄膜部に形成された開口部を介して、被処理基板に前記粒子ビームを照射する半導体製造装置において、前記ステンシルマスクに照射される、前記粒子ビームの照射領域の端部が、前記ステンシルマスクの前記薄膜部上に存在しないよう、粒子ビームの照射領域を調整することを特徴とする。

【0011】

また、上記した目的を達成するための本発明の半導体製造装置の一形態は、薄膜部及び前記薄膜部を支持する支持部を有するステンシルマスクに、粒子源及びスキャナーから粒子ビームを照射し、前記ステンシルマスクの前記薄膜部に形成された開口部を介して、被処理基板に前記粒子ビームを照射する半導体製造装置において、

前記ステンシルマスクの前記薄膜部または前記支持部の位置を測定するマスク測定装置と、

前記マスク測定装置で測定された情報を演算する演算器とを具備し、前記演算器を用いて、前記情報を前記粒子源及び前記スキャナーの少なくともいずれか一方にフィードバックすることによって、粒子ビームの照射領域を調整し、前記粒子ビームの照射を行うことを特徴とする。

【0012】

上記した本発明の形態によれば、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することができる。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

(第1の実施の形態) 梁構造部なし

図1乃至図4に本発明の第1の実施の形態に係る半導体製造装置を示す。半導体装置の製造工程において、所定のパターンを有するステンシルマスクを、被処理基板上に一定の距離を置いて設置し、ステンシルマスクのパターン開口部を通して、被処理基板に粒子ビーム（電子やイオンなどの荷電粒子ビーム、原子や分子、中性子などの中性粒子ビーム、光やX線などの電磁波ビーム）を照射する。ここでは、粒子としてイオンなどの荷電粒子を用いた場合を例に説明するが、特にこれに限定されるものではない。

【0014】

図1に示すように、半導体製造工程におけるイオン注入工程にステンシルマスク10を用いる場合、被処理基板（図示しない）の所定のイオン注入領域上に開口部を有するステンシルマスク10を用いて行われる。すなわち、イオン注入領域には、ステンシルマスクのパターン開口部を通してイオンが注入され、非注入領域では、ステンシルマスクの遮蔽部（非開口部）によって、イオンが遮蔽される。

【0015】

ステンシルマスク10は、シリコン薄膜11からなる薄膜部12と、シリコン酸化膜13及びシリコン支持基板14からなる支持部15によって構成されている。支持部15には、支持基板開口部16が形成されている。シリコン薄膜11

に形成されたステンシルマスクのパターン開口部17は、イオンなどの粒子ビームの照射領域L₁内に形成されており、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の不連続な領域18は、薄膜部12上に形成されていない。支持部15下に形成されたシリコン薄膜11には、ステンシルマスク10を製造する際に用いる位置合わせマーク19が形成されている。図2に、図1に示した半導体製造装置の平面図を示す。

【0016】

図3に、図1に示したステンシルマスクの製造方法の一例を示す。まず、図3(a)に示すように、厚さ500μm~750μm程度のシリコン支持基板21上に、熱酸化法、または、CVD法(Chemical Vapor Deposition)によって、厚さ100nm~1μm程度のシリコン酸化膜22を形成する。次いで、シリコン酸化膜22にシリコンウェハを張り合わせて研磨し、厚さ1~10μm程度のシリコン薄膜23を形成する。

【0017】

次に、図3(b)に示すように、シリコン薄膜23上にレジストを塗布し、露光及び現像することによって、レジストパターン24を形成する。レジストパターン24は、レジストとシリコン酸化膜などの絶縁膜との積層膜によるパターンで構成されていてもかまわない。

【0018】

次に、図3(c)に示すように、RIE(Reactive Ion Etching)によって、レジストパターン24をマスクとしてシリコン薄膜23をエッティングし、ステンシルマスクのパターン開口部26及び位置合わせマーク27を形成する。このとき、シリコン酸化膜22は、エッティングストッパーとして働く。

【0019】

次に、図3(d)に示すように、レジストパターン24を除去し、裏返して、シリコン酸化膜22が形成されていないシリコン支持基板21上にレジストを塗布し、露光及び現像することによって、レジストパターン28を形成する。このとき、裏面のシリコン薄膜23に形成された位置合わせマーク27を位置合わせ

用のしるしとして用いる。

【0020】

次に、図3 (e) に示すように、RIEなどのドライエッチング、及び、KOH等の薬液を用いたウェットエッチングを行い、シリコン支持基板21に支持基板開口部29を形成する。支持基板開口部29は、支持基板開口部29を形成する際のウェットエッチングの条件等に応じて、テーパー形状で形成されていてもかまわない。

【0021】

次に、図3 (f) に示すように、シリコン酸化膜22及びレジストパターン28を除去する。

【0022】

このように形成されたステンシルマスクでは、表裏の位置合わせのマージンを考慮して形成される。例えば、支持基板開口部29を主にRIEによって形成する際には、パターン開口部26と支持基板開口部29の端部は、100μm程度以下の合わせ余裕をもって形成される。また、支持基板開口部29を主にKOHなどの薬液によって形成する際には、パターン開口部26と支持基板開口部29の端部は、500μm程度以下の合わせ余裕をもって形成される。

【0023】

本実施の形態では、図1及び図2に示すように、シリコン薄膜11に形成されたステンシルマスクのパターン開口部17は、イオンなどの粒子ビームの照射領域L₁内に形成されており、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の不連続な領域18は、薄膜部12上に形成されていない。つまり、ステンシルマスク10の薄膜部12の全領域に、粒子ビームの照射を行うよう設定している。ここで、粒子ビームが照射されているステンシルマスクの薄膜部における粒子ビームの照射量は、ほぼ均一である。また、粒子ビームの照射量が、ステンシルマスクの薄膜部の所定の深さにおいて、薄膜部の表面方向に対しても均一になるように、粒子ビームが照射されている。

【0024】

ステンシルマスク10の連続した薄膜部12に、ダメージが蓄積する領域と蓄

積しない領域の境界領域に大きなストレスがかかることによる不連続な領域18が存在していないため、ステンシルマスクの変形や破損などの劣化は生じない。粒子ビームの照射領域の端部は、支持部15上に形成されており、ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の不連続な領域18が、比較的厚い支持部15上に存在しているため、この領域に大きなストレスがかかっても、ステンシルマスクの変形や破損などの劣化は生じない。したがって、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することができる。ここで、粒子ビームの照射領域の端部とは、照射量がゼロ、またはゼロではない領域の境界に限定されず、照射領域のしみ出しを考慮し、照射量の差によるストレスが、実質的に生じる、または生じない領域の境界を含む。

【0025】

また、シリコン薄膜11に形成された位置合わせマーク19は、シリコン薄膜11にパターン開口部17を形成する際に、同時に形成しているため、精度のよい位置合わせマーク19を形成するとともに、工程の追加がなく、表裏の位置合わせを容易に行うことが可能となる。

【0026】

ここで、図3に示したステンシルマスクの製造方法は一例であり、材料の寸法、薬液の種類、工程の順序等は、特に限定されない。また、表裏の位置合わせを行うために、シリコン薄膜に位置合わせマークを形成したが、形成しなくともかまわない。位置合わせマークは、溝または開口部であり、シリコン薄膜にパターン開口部を形成する際に同時に形成したが、特に限定されず、パターン開口部を形成する前に形成しても、形成した後に形成してもかまわない。また、位置合わせマークの形状もクロス形状、ドット形状、ライン形状など特に限定されない。

【0027】

また、支持基板開口部16がテーパー形状に形成されている場合は、ステンシルマスク10の薄膜部12の全領域に、照射量の均一な粒子ビームの照射を行い、図4に示すように、薄膜部12よりも厚い、テーパー形状のシリコン支持基板14上に、不連続な領域18が形成されるよう、設定してもかまわない。

(第2の実施の形態) 梁構造部あり、複数にまたがる形状あり

図5乃至図9に本発明の第2の実施の形態に係る半導体製造装置を示す。半導体装置の製造工程において、所定のパターンを有するステンシルマスクを、被処理基板上に一定の距離を置いて設置し、ステンシルマスクのパターン開口部を通して、被処理基板に粒子ビーム（電子やイオンなどの荷電粒子ビーム、原子や分子、中性子などの中性粒子ビーム、光やX線などの電磁波ビーム）を照射する。ここでは、粒子としてイオンなどの荷電粒子を用いた場合を例に説明するが、特にこれに限定されるものではない。

【0028】

図5に示すように、半導体製造工程におけるイオン注入工程にステンシルマスク40を用いる場合、被処理基板（図示しない）の所定のイオン注入領域上に開口部を有するステンシルマスク40を用いて行われる。すなわち、イオン注入領域には、ステンシルマスクのパターン開口部を通してイオンが注入され、非注入領域では、ステンシルマスクの遮蔽部（非開口部）によって、イオンが遮蔽される。

【0029】

ステンシルマスク40は、シリコン薄膜41からなる薄膜部42と、シリコン酸化膜43及びシリコン支持基板44からなる支持部45によって構成されている。支持部45には、支持基板開口部46が形成されている。支持基板開口部46内に形成された一部のシリコン薄膜41上には、シリコン支持基板44からなる複数の梁構造部、ここでは、第1及び第2の梁構造部45a, 45bが形成されている。このような梁構造部は、例えば、ステンシルマスクに形成されるパターンに応じて形成することができる。また、ステンシルマスクの強度を向上させることができる。シリコン薄膜41に形成されたステンシルマスクのパターン開口部47は第1及び第2の梁構造部45a, 45b間、または、梁構造部と支持部の間に形成されている。本実施の形態では、第1及び第2の梁構造部45a, 45b間のシリコン薄膜41は、イオンなどの粒子ビームの照射領域L₂内に形成されており、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の不連続な領域48は、薄膜部42上に形成されていない。支持部45下に形成されたシリコン薄膜41には、ステンシルマスク40を製造する際に用いる位置合わせマーク49が形

成されている。図6 (a) 及び図6 (b) に、図5に示した半導体製造装置の平面図を示す。

【0030】

第1及び第2の梁構造部45a, 45b間の、ステンシルマスク40の薄膜部42の幅、梁開口部46aをA₂とし、第1及び第2の梁構造部45a, 45bの幅をそれぞれB₂, C₂とすると、イオンなどの粒子ビームの照射領域L₂は、 $A_2 < L_2 < (A_2 + B_2 + C_2)$ となる。ステンシルマスクの製造方法は、前記した第1の実施の形態において、図3を用いて示した工程とほぼ同じであるため、説明を省略する。

【0031】

本実施の形態では、シリコン薄膜41に形成されたステンシルマスクのパターン開口部47は、梁構造部間、または、梁構造部と支持部の間に形成されている。第1及び第2の梁構造部45a, 45b間のシリコン薄膜41は、イオンなどの粒子ビームの照射領域L₂内に形成されており、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の不連続な領域48は、薄膜部42上に形成されていない。つまり、ステンシルマスク40の薄膜部42の全領域に、粒子ビームの照射を行うよう設定している。ここで、粒子ビームが照射されているステンシルマスクの薄膜部における粒子ビームの照射量は、ほぼ均一である。また、粒子ビームの照射量が、ステンシルマスクの薄膜部の所定の深さにおいて、薄膜部の表面方向に対しても均一になるように、粒子ビームが照射されている。

【0032】

ステンシルマスク40の連続した薄膜部42に、ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の境界領域に大きなストレスがかからることによる不連続な領域48が存在していないため、ステンシルマスクの変形や破損などの劣化は生じない。粒子ビームの照射領域の端部は、第1及び第2の梁構造部45a, 45b上に形成されており、ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の境界領域の不連続な領域48は、比較的厚い第1及び第2の梁構造部45a, 45b上に存在しているため、この領域大きなストレスがかかっても、ステンシルマスクの変形や破損などの劣化は生じない。第1及び第2の梁構造部45a, 45b間の、ステンシ

ルマスク40の薄膜部42は、粒子源等の半導体製造装置の設定に応じて、面積の調整を行うことができるため、比較的容易に、ステンシルマスク40の薄膜部42の領域に、均一に照射を行うことができる。したがって、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することができる。ここで、粒子ビームの照射領域の端部とは、照射量がゼロ、またはゼロではない領域の境界に限定されず、照射領域のしみ出しを考慮し、照射量の差によるストレスが、実質的に生じる、または生じない領域の境界を含む。

【0033】

また、支持部45下のシリコン薄膜41に形成された位置合わせマーク49は、シリコン薄膜41にパターン開口部47を形成する際に、同時に形成することができ、同時に形成することによって、精度のよい位置合わせマーク49を形成するとともに、工程の追加がなく、表裏の位置合わせを容易に行うことが可能となる。

【0034】

図3に示したステンシルマスクの製造方法は一例であり、材料の寸法、薬液の種類、工程の順序等は、特に限定されない。また、表裏の位置合わせを行うために、支持部45下に形成されたシリコン薄膜41に、位置合わせマーク49を形成したが、形成しなくてもかまわない。ただし、梁構造部を有するステンシルマスクでは、さらに高精度な表裏の位置合わせを行う必要があるため、位置合わせマークを形成することによって、高精度な表裏の位置合わせを容易に行うことができ、特に有効である。また、位置合わせマーク49は、溝または開口部であり、パターン開口部47を形成する前に形成しても、形成した後に形成してもかまわない。また、位置合わせマーク49の形状もクロス形状、ドット形状、ライン形状など特に限定されない。

【0035】

また、梁開口部46aがテーパー形状に形成された場合は、ステンシルマスク40の薄膜部42の全領域に、照射量の均一な粒子ビームの照射を行い、図7に示すように、薄膜部42よりも厚い、テーパー形状のシリコン支持基板44上に、不連続な領域48が形成されるよう、設定してもかまわない。

(第2の実施の形態の第1の変形例)

前記した第2の実施の形態では、梁構造部が2つ形成された場合について記載したが、特にこれに限定されない。第1の変形例では、図8に示すように、第1乃至第4の梁構造部を有する例について記載する。

【0036】

ステンシルマスク60は、シリコン薄膜61からなる薄膜部62と、シリコン酸化膜63及びシリコン支持基板64からなる支持部65によって構成されている。支持部65には、支持基板開口部66が形成されている。支持基板開口部66内に形成された一部のシリコン薄膜71上には、シリコン支持基板74からなる複数の梁構造部、ここでは、第1乃至第4の梁構造部65a, 65b, 65c, 65dが形成されている。このような梁構造部は、例えば、ステンシルマスクに形成されるパターンに応じて形成することができる。また、ステンシルマスクの強度を向上させることができる。シリコン薄膜61に形成されたステンシルマスクのパターン開口部67は、第1及び第2の梁構造部65a, 65b間、または、梁構造部と支持部の間に形成されている。本実施の形態では、第2乃至第4の梁構造部65b, 65c, 65d間のシリコン薄膜61は、イオンなどの粒子ビームの照射領域 L_3 内に形成されており、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の不連続な領域68は、薄膜部62上に形成されていない。つまり、第2及び第4の梁構造部65b, 65c, 65d間の、ステンシルマスク60の薄膜部62の全領域に、粒子ビームの照射を行うよう設定している。支持部65下に形成されたシリコン薄膜61には、ステンシルマスク60を製造する際に用いる位置合わせマーク69が形成されている。

【0037】

第2乃至第4の梁構造部65b, 65c, 65dの梁構造部間の、ステンシルマスク60の薄膜部62の幅、梁開口部66aをそれぞれ A_3 とし、第2乃至第4の梁構造部65b, 65c, 65dの幅をそれぞれ B_3 , C_3 , D_3 とすると、イオンなどの粒子ビームの照射領域 L_3 は、 $(2A_3+C_3) < L_3 < (2A_3+B_3+C_3+D_3)$ となる。ステンシルマスクの製造方法は、前記した第1の実施の形態において、図3を用いて示した工程とほぼ同じであるため、説明を省略する

【0038】

本実施の形態では、第2乃至第4の梁構造部65b, 65c, 65dの梁構造部間の、ステンシルマスク60の薄膜部62は、粒子源等の半導体製造装置の設定に応じて、面積を調整して製造することができるため、比較的容易に、ステンシルマスク60の薄膜部62の領域に、粒子ビームの照射を行うよう設定することができる。したがって、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することができる。

【0039】

また、梁開口部66aがテーパー形状に形成された場合は、ステンシルマスク60の薄膜部62の全領域に、照射量の均一な粒子ビームの照射を行い、薄膜部62よりも厚い、テーパー形状のシリコン支持基板64上に、不連続な領域68が形成されるよう、設定してもかまわない（図示しない）。

【0040】

本実施の形態では、支持基板開口部内に、2つまたは4つの梁構造部を形成した例を記載したが、これに限定されず、n（1または複数）の梁構造部を形成することができる。ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の不連続な領域が、2つの梁構造部上に存在する例を記載したがこれに限定されず、図9に示すように、一方が支持部上に存在するように形成されていてもかまわない。また、粒子ビームの照射領域 L_n の内側に形成される梁構造部は、0または1つである例を記載したがこれに限定されない。

（第3の実施の形態）アパーチャーアリ

図10乃至図12に本発明の第3の実施の形態に係る半導体装置を示す。半導体装置の製造工程において、所定のパターンを有するステンシルマスクを被処理基板上に一定の距離を置いて設置し、ステンシルマスクのパターン開口部を通して粒子（電子やイオンなどの荷電粒子、原子や分子、中性子などの中性粒子、光やX線などの電磁波）を被処理基板に照射する。ここでは、粒子としてイオンなどの荷電粒子を用いた場合を例に説明するが、特にこれに限定されるものではない。

【0041】

図10に示すように、半導体製造工程におけるイオン注入工程にステンシルマスク80を用いる場合、被処理基板（図示しない）の所定のイオン注入領域上に開口部を有するステンシルマスク80を用いて行われる。すなわち、イオン注入領域には、ステンシルマスクのパターン開口部を通してイオンが注入され、非注入領域では、ステンシルマスクの遮蔽部（非開口部）によって、イオンが遮蔽される。

【0042】

ステンシルマスク80は、シリコン薄膜81からなる薄膜部82と、シリコン酸化膜83及びシリコン支持基板84からなる支持部85によって構成されている。支持部85には、支持基板開口部86が形成されている。支持基板開口部86内に形成された一部のシリコン薄膜81上には、シリコン支持基板84からなる複数の梁構造部、ここでは、第1及び第2の梁構造部85a, 85bが形成されている。このような梁構造部は、例えば、ステンシルマスクに形成されるパターンに応じて形成することができる。また、ステンシルマスクの強度を向上させることができる。シリコン薄膜81に形成されたステンシルマスクのパターン開口部87は、第1及び第2の梁構造部85a, 85b間、または、梁構造部と支持部の間に形成されている。本実施の形態では、第1及び第2の梁構造部85a, 85b間のシリコン薄膜81が、イオンなどの粒子ビームの照射領域L4内に形成されるよう、ステンシルマスク80上にシリコンなどで形成されたアーチャー50を設置し、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の不連続な領域88は、薄膜部82上に形成されていない。支持部85下に形成されたシリコン薄膜81には、ステンシルマスク80を製造する際に用いる位置合わせマーク89が形成されている。

【0043】

第1及び第2の梁構造部85a, 85b間の、ステンシルマスク80の薄膜部82の幅、梁開口部86aをA4とし、第1及び第2の梁構造部85a, 85bの幅をそれぞれB4, C4とすると、イオンなどの粒子ビームの照射領域L4は、 $A_4 < L_4 < (A_4 + B_4 + C_4)$ となる。ステンシルマスクの製造方法は、前記し

た第1の実施の形態において、図3を用いて示した工程とほぼ同じであるため、説明を省略する。

【0044】

本実施の形態では、シリコン薄膜81に形成されたステンシルマスクのパターン開口部87は、梁構造部間、または、梁構造部と支持部の間に形成されている。ステンシルマスク80上にシリコンなどで形成されたアパーチャー50を設置し、第1及び第2の梁構造部85a, 85b間のシリコン薄膜81が、イオンなどの粒子ビームの照射領域 L_4 内に形成されるよう、粒子ビームの照射領域 L_4 を制限している。粒子ビームが照射される領域と非照射領域の不連続な領域88は、薄膜部82上に形成されていない。つまり、第1及び第2の梁構造部85a, 85b間の、ステンシルマスク80の薄膜部82の全領域に、粒子ビームの照射を行うよう設定している。ここで、粒子ビームが照射されているステンシルマスクの薄膜部における粒子ビームの照射量は、ほぼ均一である。また、粒子ビームの照射量が、ステンシルマスクの薄膜部の所定の深さにおいて、薄膜部の表面方向に対しても均一になるように、粒子ビームが照射されている。

【0045】

ステンシルマスク80の連続した薄膜部82に、ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の境界領域に大きなストレスがかかることによる不連続な領域88が存在していないため、ステンシルマスクの変形や破損などの劣化は生じない。粒子ビームの端部は、梁構造部上に形成されており、ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の不連続な領域88が、比較的厚い梁構造部上に存在しているため、この領域に大きなストレスがかかっても、ステンシルマスクの変形や破損などの劣化は生じない。

【0046】

また、粒子ビームの照射領域 L_4 は、半導体製造装置の仕様や設定にかかわらずアパーチャーを設置することによって、容易に制限することができる。第1及び第2の梁構造部85a, 85b間の、ステンシルマスク80の薄膜部82は、粒子源等の半導体製造装置の設定に応じて、面積の調整を行うとともに、アパーチャーを用いて粒子ビームの照射領域 L_4 を調整することができるため、さらに

容易に、ステンシルマスク80の薄膜部82の領域に、均一に照射を行うことができる。したがって、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することができる。ここで、粒子ビームの照射領域の端部とは、照射量がゼロ、またはゼロではない領域の境界に限定されず、照射領域のしみ出しを考慮し、照射量の差によるストレスが、実質的に生じる、または生じない領域の境界を含む。

【0047】

また、支持部85下のシリコン薄膜81に形成された位置合わせマーク89は、シリコン薄膜81にパターン開口部87を形成する際に、同時に形成することができ、同時に形成することによって、精度のよい位置合わせマーク89を形成するとともに、工程の追加がなく、表裏の位置合わせを容易に行うことが可能となる。

【0048】

図3に示したステンシルマスクの製造方法は一例であり、材料の寸法、薬液の種類、工程の順序等は、特に限定されない。また、表裏の位置合わせを行うために、支持部85下に形成されたシリコン薄膜81に、位置合わせマーク89を形成したが、形成しなくてもかまわない。ただし、梁構造部を有するステンシルマスクでは、さらに高精度な表裏の位置合わせを行う必要があるため、位置合わせマークを形成することによって、高精度な表裏の位置合わせを容易に行うことができ、特に有効である。また、位置合わせマーク89は、溝または開口部であり、パターン開口部87を形成する前に形成しても、形成した後に形成してもかまわない。また、位置合わせマーク89の形状もクロス形状、ドット形状、ライン形状など特に限定されない。

【0049】

また、梁開口部86aがテーパー形状に形成された場合は、ステンシルマスク80の薄膜部82の全領域に、照射量の均一な粒子ビームの照射を行い、薄膜部82よりも厚い、テーパー形状のシリコン支持基板84上に、不連続な領域88が形成されるよう、設定してもかまわない（図示しない）。

【0050】

また、本実施の形態は、図11に示すように、前記した第2の実施の形態の第1の変形例で記載した図8に適用することも可能である。

【0051】

すなわち、図11に示すように、シリコン薄膜91に形成されたステンシルマスクのパターン開口部97は、梁構造部間、または、梁構造部と支持部の間に形成されている。ステンシルマスク90上にシリコンなどで形成されたアーチャー50を設置し、第2乃至第4の梁構造部95b, 95c, 95d間のシリコン薄膜91が、イオンなどの粒子ビームの照射領域L₅内に形成されるよう、粒子ビームの照射領域L₅を制限している。粒子ビームが照射される領域と非照射領域の不連続な領域98は、薄膜部92上に形成されていない。つまり、第2乃至第4の梁構造部95b, 95c, 95dの梁構造部間の、ステンシルマスク90の薄膜部92の全領域に、粒子ビームの照射を行うよう設定している。

【0052】

また、粒子ビームの照射領域L₅は、半導体製造装置の仕様や設定にかかわらずアーチャーを設置することによって、容易に制限することができる。第2乃至第4の梁構造部95b, 95c, 95dの梁構造部間の、ステンシルマスク90の薄膜部92は、粒子源等の半導体製造装置の設定に応じて、面積の調整を行うとともに、アーチャーを用いて粒子ビームの照射領域L₅を調整することができるため、さらに容易に、ステンシルマスク90の薄膜部92の領域に、均一に照射を行うことができる。したがって、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することができる。また、梁開口部96aがテーパー形状に形成された場合（図示しない）は、不連続な領域がテーパー形状のシリコン支持基板上に形成されていてもかまわない。

【0053】

さらに、本実施の形態は、図12に示すように、本実施の形態で記載した図10にアーチャーを複数枚（ここでは、2枚）設置して所望の照射領域を形成する方法を適用することも可能である。

【0054】

すなわち、図12示すように、シリコン薄膜101に形成されたステンシルマ

スクのパターン開口部107は、梁構造部間、または、梁構造部と支持部の間に形成されている。ステンシルマスク100上にシリコンなどで形成されたアパー チャー50を2枚設置し、第1及び第2の梁構造部105a, 105b間のシリ コン薄膜部102が、イオンなどの粒子ビームの照射領域L₆内に形成されるよ う、粒子ビームの照射領域L₆を制限している。粒子ビームが照射される領域と 非照射領域の不連続な領域108は、薄膜部102上に形成されていない。つまり、第1及び第2の梁構造部105a, 105b間の、ステンシルマスク100 の薄膜部102の全領域に、粒子ビームの照射を行うよう設定している。

【0055】

また、粒子ビームの照射領域L₆は、半導体製造装置の仕様や設定にかかわら ずアパー チャーを設置することによって、容易に制限することができる。第1及 び第2の梁構造部105a, 105b間の、ステンシルマスク100の薄膜部1 02は、粒子源等の半導体製造装置の設定に応じて、面積の調整を行うとともに 、アパー チャーを複数枚用いて粒子ビームの照射領域L₆を可変とすることが容 易にでき、ステンシルマスクの形状に応じて、粒子ビームの照射領域L₆の調整 を行うことができるため、さらに容易に、ステンシルマスク100の薄膜部10 2の領域に、均一に照射を行うことができる。

【0056】

したがって、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損な どの劣化を抑止することができる。また、梁開口部106aがテーパー形状に形 成された場合（図示しない）は、不連続な領域108がテーパー形状のシリコン 支持基板104上に形成されていてもかまわない。

【0057】

さらに、本実施の形態は、本実施の形態で記載した図11にアパー チャーを複 数枚（ここでは、2枚）設置して所望の照射領域を形成する方法を適用すること も可能である（図示しない）。

【0058】

以上、本実施の形態では、支持基板開口部内に、2つまたは4つの梁構造部を 形成した例を記載したが、これに限定されず、n（1または複数）の梁構造部を

形成することができる。ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の不連続な領域が、2つの梁構造部上に存在する例を記載したがこれに限定されず、一方が支持部上に存在するように形成されていてもかまわない（図示しない）。また、粒子ビームの照射領域 L_n の内側に形成される梁構造部は、0または1つである例を記載したがこれに限定されない。

（第4の実施の形態）

図13に本発明の第4の実施の形態に係る半導体製造装置を示す。半導体装置の製造工程において、所定のパターンを有するステンシルマスクを、被処理基板上に一定の距離を置いて設置し、ステンシルマスクのパターン開口部を通して、被処理基板に粒子ビーム（電子やイオンなどの荷電粒子ビーム、原子や分子、中性子などの中性粒子ビーム、光やX線などの電磁波ビーム）を照射する。ここでは、粒子としてイオンなどの荷電粒子を用いた場合を例に説明するが、特にこれに限定されるものではない。

【0059】

本実施の形態では、粒子源から粒子ビームを放射し、例えば、スキャナーによって照射領域を調整し、コリメータからステンシルマスクに粒子ビームを照射する半導体製造装置に付帯して、ステンシルマスクの厚さ等のマスクの形状を測定する（または判定する）マスク測定装置を設置している。

【0060】

図13に示すように、粒子源111から粒子としてイオンなどの荷電粒子を放射し、例えば、スキャナー112を用いて、放射領域の調整を行っている。ここでは、静電スキャン方式によるスキャナーを用いて、スキャン領域を調整している。なお、粒子源から放射される粒子が光である場合は、光学レンズ、アーチャー等を用いて、放射領域の調整を行う。

【0061】

また、ステンシルマスクの厚さ等のマスクの形状を測定する（または判定する）ために、マスク測定装置113が設置されており、マスク測定装置113では、ステージ上に移動したステンシルマスクの厚さをレーザー変位計等によって測定し、ステンシルマスクの薄膜部が形成されている領域、または、厚膜部である

支持部や梁構造部が形成されている領域を調べる。ステンシルマスクの薄膜部が形成されている領域などの形状に関する情報は、演算器114を通じて粒子源111及びスキャナー112にフィードバックされ、ステンシルマスクの形状に応じて、ステンシルマスクに照射される照射領域の調整を行う。続いて、スキャナー112からコリメータ115に粒子ビームを入射し、ステンシルマスク110に粒子ビームを照射している。ステンシルマスクは、所定のパターンを有しており、被処理基板116上に一定の距離を置いて設置されている。ステンシルマスクのパターン開口部を通して粒子ビームを被処理基板116に照射し、被処理基板116に対して、所定の処理を行う。

【0062】

粒子ビームの照射領域の調整では、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の不連続な領域が、ステンシルマスクの支持部または梁構造部上に形成されるよう調整する。このように調整することによって、支持部間、または梁構造部間、または支持部と梁構造部間の、ステンシルマスクの薄膜部の全領域に粒子ビームの照射を行うことができるため、ステンシルマスクの連続した薄膜部に、ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の不連続な領域が存在せず、粒子の照射領域の端部が、比較的厚い支持部または梁構造部上に存在しているため、大きなストレスがかかっても、ステンシルマスクの変形や破損などの劣化は生じない。したがって、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することができる。ここで、粒子ビームの照射領域の端部とは、照射量がゼロ、またはゼロではない領域の境界に限定されず、照射領域のしみ出しを考慮し、照射量の差によるストレスが、実質的に生じる、または生じない領域の境界を含む。

【0063】

また、支持部または梁開口部がテーパー形状に形成されている場合（図示しない）は、不連続な領域が、テーパー形状の支持部または梁構造部上になるよう調整してもかまわない。支持基板開口部内に形成される梁構造部は、2つまたは4つに限定されず、n（1または複数）の梁構造部を形成することができる。また、粒子ビームの照射領域の内側に形成される梁構造部は、0または1つに限定さ

れず、所望の数だけ形成することができる。

【0064】

また、粒子ビームの照射領域の調整では、粒子源から放射される粒子ビームのほぼ全てがステンシルマスクの照射領域内に照射されるよう、調整することが最も好ましい。さらに、単位時間に単位面積に照射される粒子量が最大となるよう調整することによって、被処理基板の処理時間を短くすることができる。また、粒子ビームが照射されているステンシルマスクの薄膜部における粒子ビームの照射量は、ほぼ均一である。また、粒子ビームの照射量が、ステンシルマスクの薄膜部の所定の深さにおいて、薄膜部の表面方向に対しても均一になるように、粒子ビームが照射されている。

【0065】

前記した第3の実施の形態に記載したように、ステンシルマスクの上方に、1枚または複数枚のアパーチャーを設置してもよい。マスク測定装置によって測定された情報、すなわちステンシルマスクの薄膜部が形成されている領域、または、厚膜である支持部や梁構造部が形成されている領域に関する情報を、演算器を通じてアパーチャーにフィードバックし、ステンシルマスクの形状に応じて、ステンシルマスクに照射される照射領域の調整を行うことも可能である。このように、アパーチャーを設置することによって、粒子ビームの照射領域を可変にし、半導体製造装置の仕様や設定にかかわらず、粒子ビームの照射領域を容易に制限することができる。また、演算器を通じて、アパーチャーに情報をフィードバックする例を記載したが、これに限定されず、アパーチャー、粒子源及びスキャナーの少なくともいずれか一つに、演算器を通じて情報をフィードバックして、ステンシルマスクに照射される照射領域の調整を行うことも可能である。

【0066】

マスク測定装置は、レーザー変位計を有する装置に限定されず、画像認識によって、ステンシルマスクの薄膜部が形成されている領域、または、厚膜である支持部や梁構造部が形成されている領域を調べる方法であってもかまわない。また、ステンシルマスクの薄膜部、支持部及び梁構造部などに、ステンシルマスクの形状・種別に対応したナンバリングやネーミングを施し、画像認識等の手段によ

って、ステンシルマスクの形状・種別を認識し、ステンシルマスクに照射される照射領域の調整を行うことも可能である。また、ステンシルマスクの薄膜部、支持部及び梁構造部などに、ステンシルマスクの薄膜部が形成されている領域、または、厚膜部である支持部や梁構造部の形成されている領域の大きさに関する情報を書き込み、画像認識等の手段によって、ステンシルマスクの薄膜部等が形成されている領域の大きさに関する情報を調べ、ステンシルマスクに照射される照射領域の調整を行うことも可能である。

【0067】

本実施の形態は、前記した第1乃至第3の実施の形態に記載したステンシルマスクに適用することが可能である。

(第5の実施の形態)

図14に本発明の第5の実施の形態に係る半導体製造装置を示す。半導体装置の製造工程において、所定のパターンを有するステンシルマスクを、被処理基板上に一定の距離を置いて設置し、ステンシルマスクのパターン開口部を通して、被処理基板に粒子ビーム（電子やイオンなどの荷電粒子ビーム、原子や分子、中性子などの中性粒子ビーム、光やX線などの電磁波ビーム）を照射する。ここでは、粒子としてイオンなどの荷電粒子を用いた場合を例に説明するが、特にこれに限定されるものではない。

【0068】

図14（a）に示すように、半導体製造工程におけるイオン注入工程にステンシルマスク10を用いる場合、被処理基板（図示しない）の所定のイオン注入領域上に開口部を有するステンシルマスク10を用いて行われる。すなわち、イオン注入領域には、ステンシルマスクのパターン開口部を通してイオンが注入され、非注入領域では、ステンシルマスクの遮蔽部（非開口部）によって、イオンが遮蔽される。

【0069】

ステンシルマスク10は、シリコン薄膜11からなる薄膜部12と、シリコン酸化膜13及びシリコン支持基板14からなる支持部15によって構成されている。支持部15には、支持基板開口部16が形成されている。シリコン薄膜11

に形成されたステンシルマスクのパターン開口部17は、イオンなどの粒子ビームの照射領域 L_{71} 内に形成されており、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の境界領域である、照射領域の端部は、薄膜部12上に形成されている。支持部15下に形成されたシリコン薄膜11には、ステンシルマスク10を製造する際に用いる位置合わせマーク19が形成されている。

【0070】

続いて、図14(b)に示すように、ステンシルマスク10の薄膜部12において、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の境界領域に大きなストレスがかかるのを抑止するために、ステンシルマスク10を用いた半導体製造工程の間に、粒子ビームの非照射領域に粒子ビームを照射(粒子ビームの照射領域 L_{72})し、ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の不連続な領域が生じないよう、粒子ビームの照射量の差を緩和する工程を追加して行っている。ここで、粒子ビームが照射される領域と非照射領域の境界領域である、照射領域の端部とは、照射量がゼロ、またはゼロではない領域の境界に限定されず、照射領域のしみ出しを考慮し、照射量の差によるストレスが、実質的に生じる、または生じない領域の境界を含む。

【0071】

粒子ビームの照射量の差を緩和する工程は、ステンシルマスクを用いた半導体製造工程の間に、複数回行ってもよい。また、あるロットの半導体製造工程を終了した後、次のロットの半導体製造工程を実施する前に行ってもよい。

【0072】

この粒子ビームの照射量の差を緩和する工程は、粒子ビームの非照射領域に粒子ビームの照射を行うことに限定されない。特に、粒子がイオンの場合には、アーナー処理などの熱処理を行うことによって、ステンシルマスク中に溜まった粒子を拡散させ、粒子ビームの照射量の差を緩和してもよい。また、薬液処理を行うことによって、粒子ビームの照射量の差を緩和してもよい。

【0073】

以上、第1乃至第5の実施の形態では、粒子として荷電粒子を用い、イオン注入工程でステンシルマスクを用いる例について記載したが、粒子として、電子を

用い、レジストパターン形成工程でステンシルマスクを用いてもかわまない。レジストパターン形成工程では、電子ビームの照射領域を調整しながら電子ビームの照射を行い、工程の最終状態において、ステンシルマスクの薄膜部に電子ビームの照射領域の端部が存在しないように電子ビームの照射領域を調整する。あるいは、ステンシルマスクの薄膜部に電子ビームの照射領域の端部が存在するときには、ダメージが蓄積する領域と蓄積しない領域の不連続な領域がステンシルマスクの薄膜部に生じないように、照射量の差を緩和する工程を追加して行う。

【0074】

【発明の効果】

以上詳述したように、本発明によれば、半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態に係る半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図2】 本発明の第1の実施の形態に係る半導体製造装置を示す平面図である。

【図3】 本発明の第1の実施の形態に係る半導体製造装置の製造方法の一工程を示す要部断面図である。

【図4】 本発明の第1の実施の形態に係る他の半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図5】 本発明の第2の実施の形態に係る半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図6】 本発明の第2の実施の形態に係る半導体製造装置を示す平面図である。

【図7】 本発明の第2の実施の形態に係る他の半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図8】 本発明の第2の実施の形態に係る他の半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図9】 本発明の第2の実施の形態に係る他の半導体製造装置を示す要部断面

図である。

【図10】 本発明の第3の実施の形態に係る半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図11】 本発明の第3の実施の形態に係る他の半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図12】 本発明の第3の実施の形態に係る他の半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図13】 本発明の第4の実施の形態に係る半導体製造装置を示す概略図である。

【図14】 本発明の第5の実施の形態に係る半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図15】 従来の技術の半導体製造装置を示す要部断面図である。

【図16】 従来の技術の半導体製造装置を示す平面図である。

【図17】 従来の技術の半導体製造装置を示す概略図である。

【図18】 従来の技術の半導体製造装置の問題点を示す要部断面図である。

【符号の説明】

10, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130 ステンシルマスク

11, 23, 41, 61, 81, 91, 101, 122 シリコン薄膜

12, 42, 62, 82, 92, 102, 123 薄膜部

13, 22, 43, 63, 83, 93, 103, 124 シリコン酸化膜

14, 21, 44, 64, 84, 94, 104, 125 シリコン支持基板

15, 45, 65, 85, 95, 105, 126 支持部

16, 29, 46, 66, 86, 96, 106 支持基板開口部

17, 26, 47, 67, 87, 97, 107, 121 パターン開口部

18, 48, 68, 88, 98, 108, 142 不連続な領域

19, 27, 49, 69, 89, 99, 109 位置合わせマーク

24, 28 レジストパターン

45a, 65a, 85a, 95a, 105a 第1の梁構造部

45b, 65b, 85b, 95b, 105b 第2の梁構造部

46a, 66a, 86a, 96a, 106a 梁開口部

50 アパーチャー

65c, 95c 第3の梁構造部

65d, 95d 第4の梁構造部

111, 131 粒子源

112, 132 スキヤナー

113 マスク測定装置

114 演算器

115, 133 コリメータ

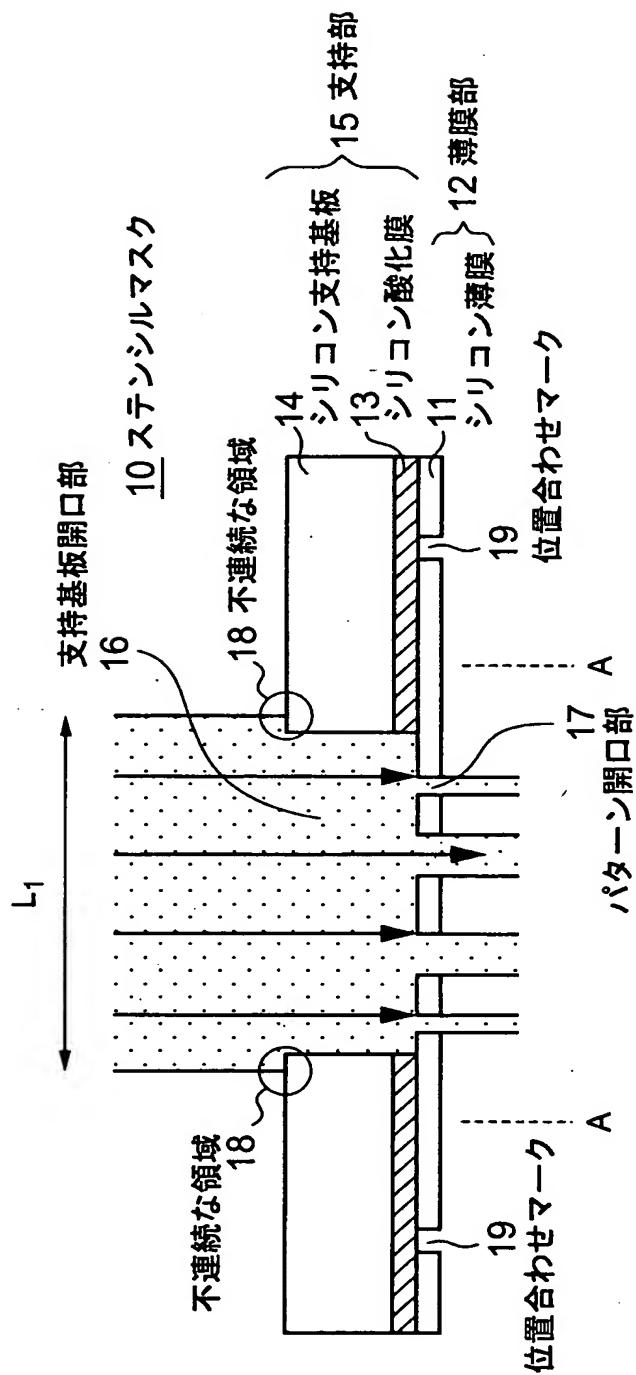
116, 134 被処理基板

141 ダメージ

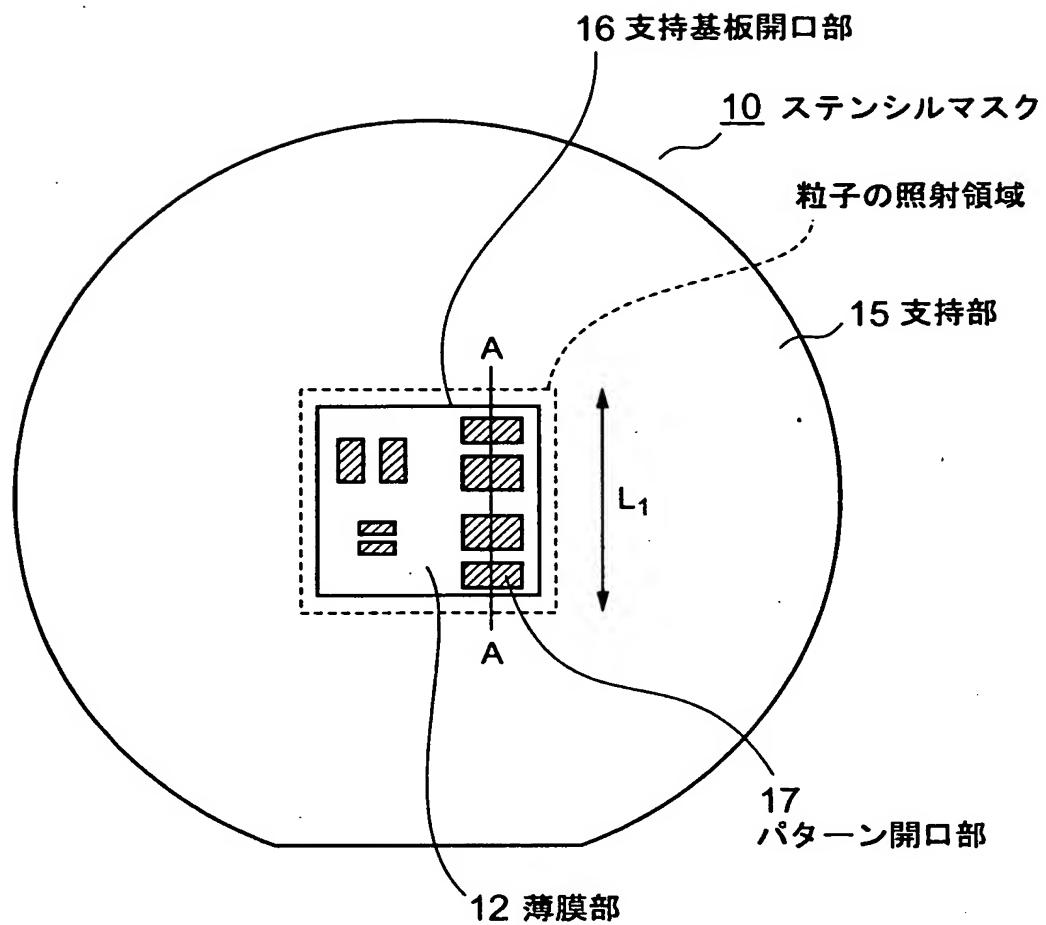
【書類名】

四面

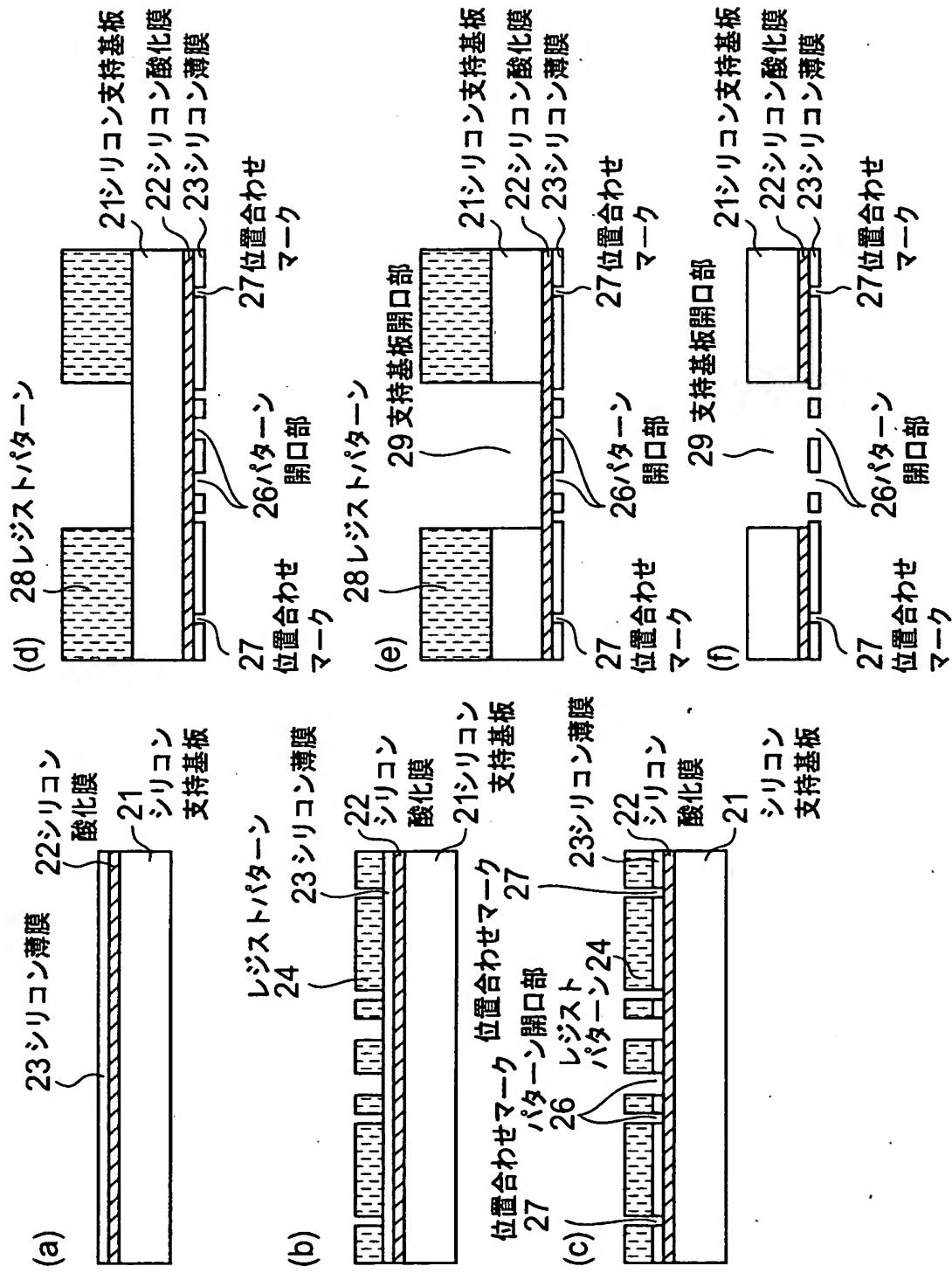
【図1】



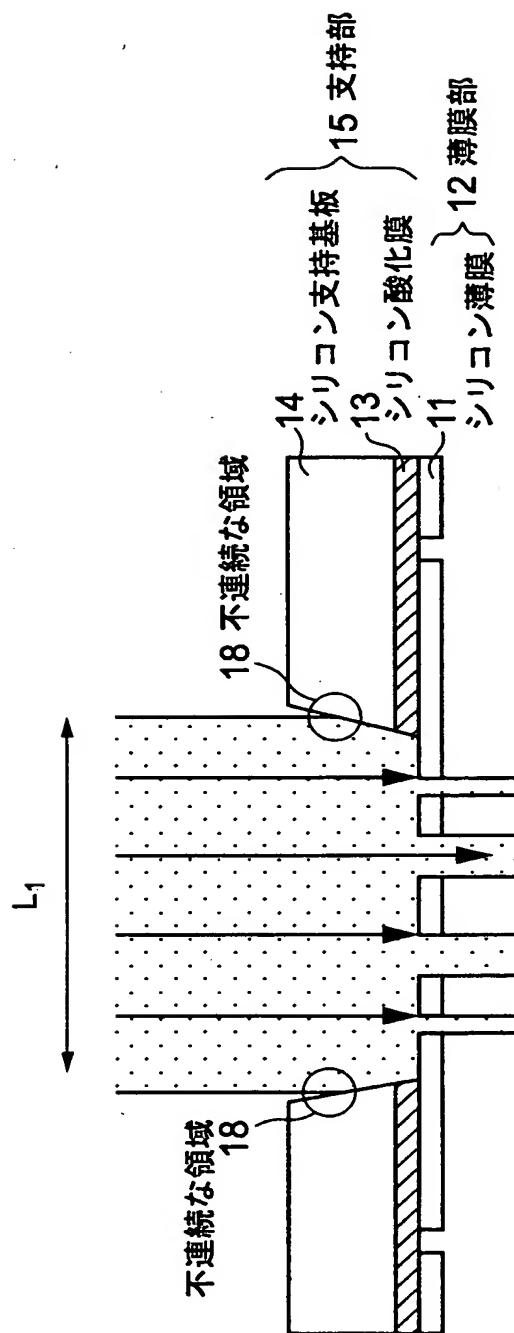
【図2】



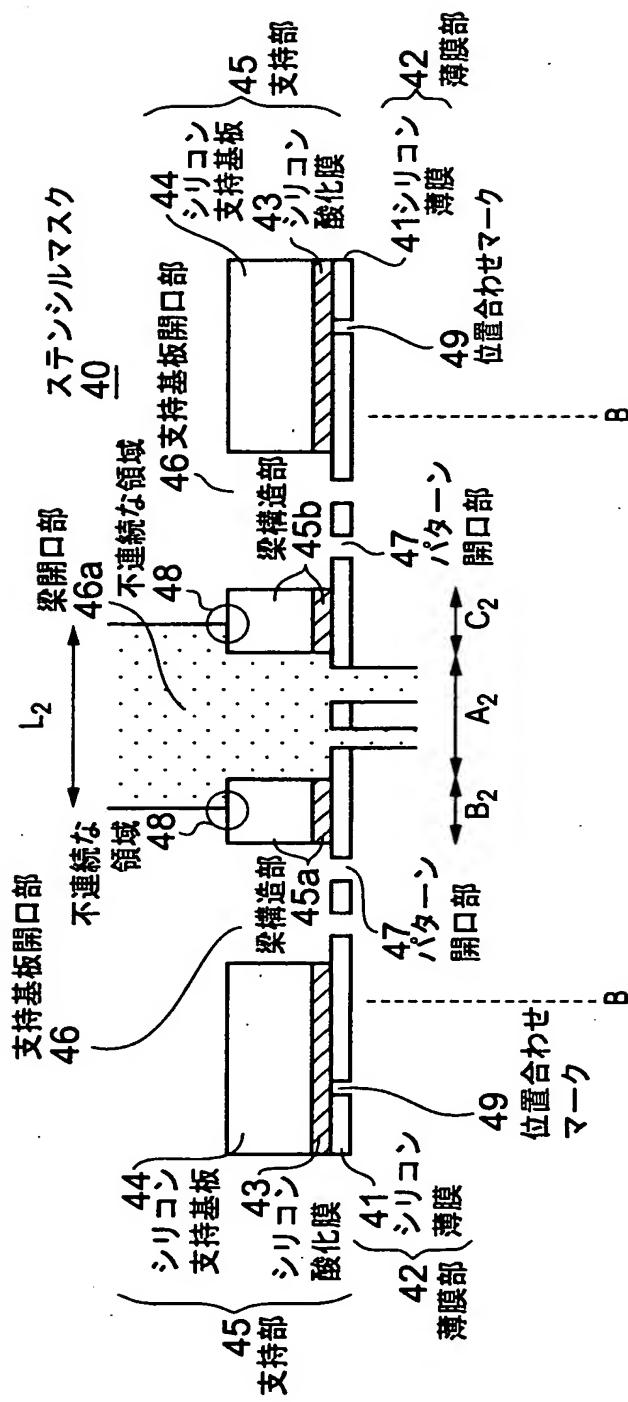
【図3】



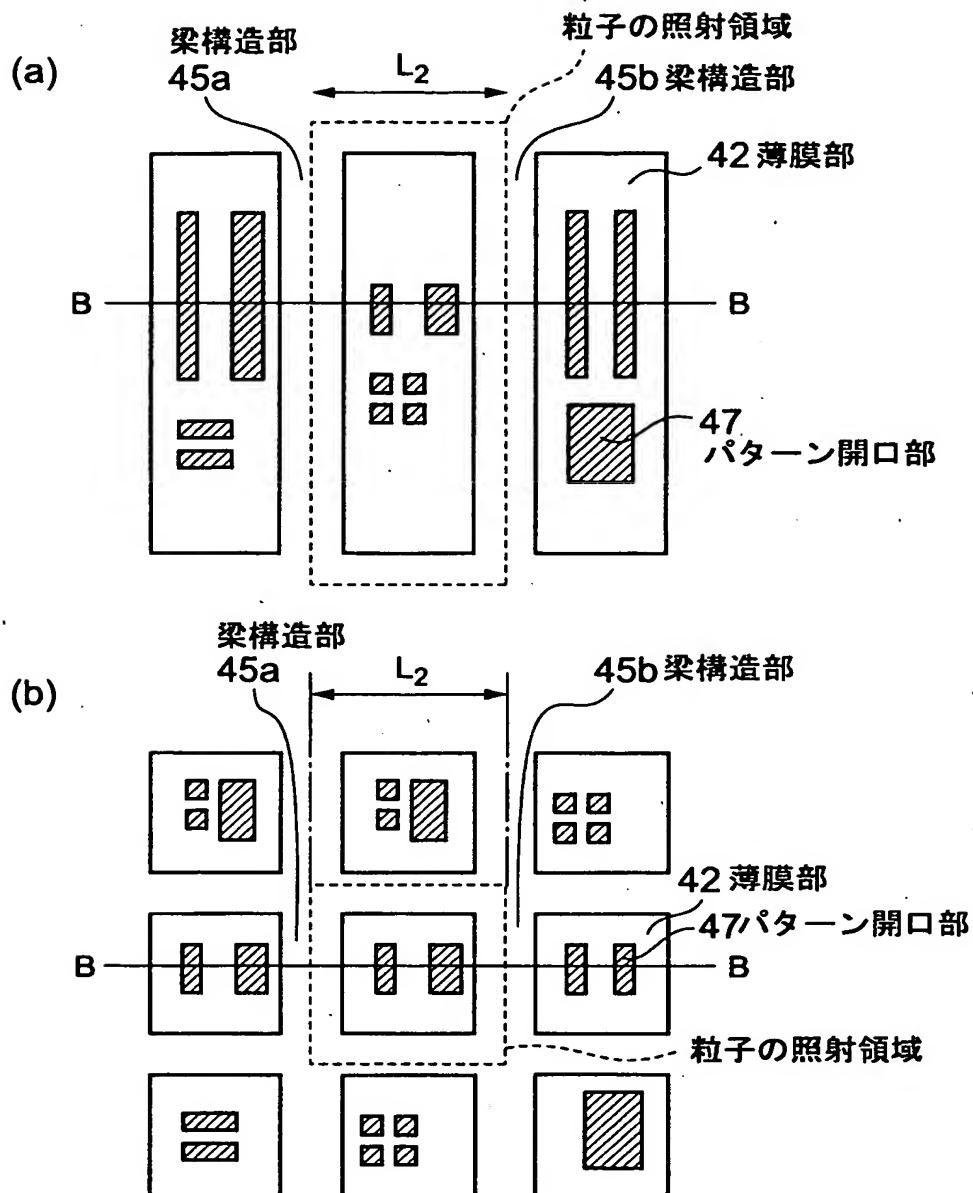
【図4】



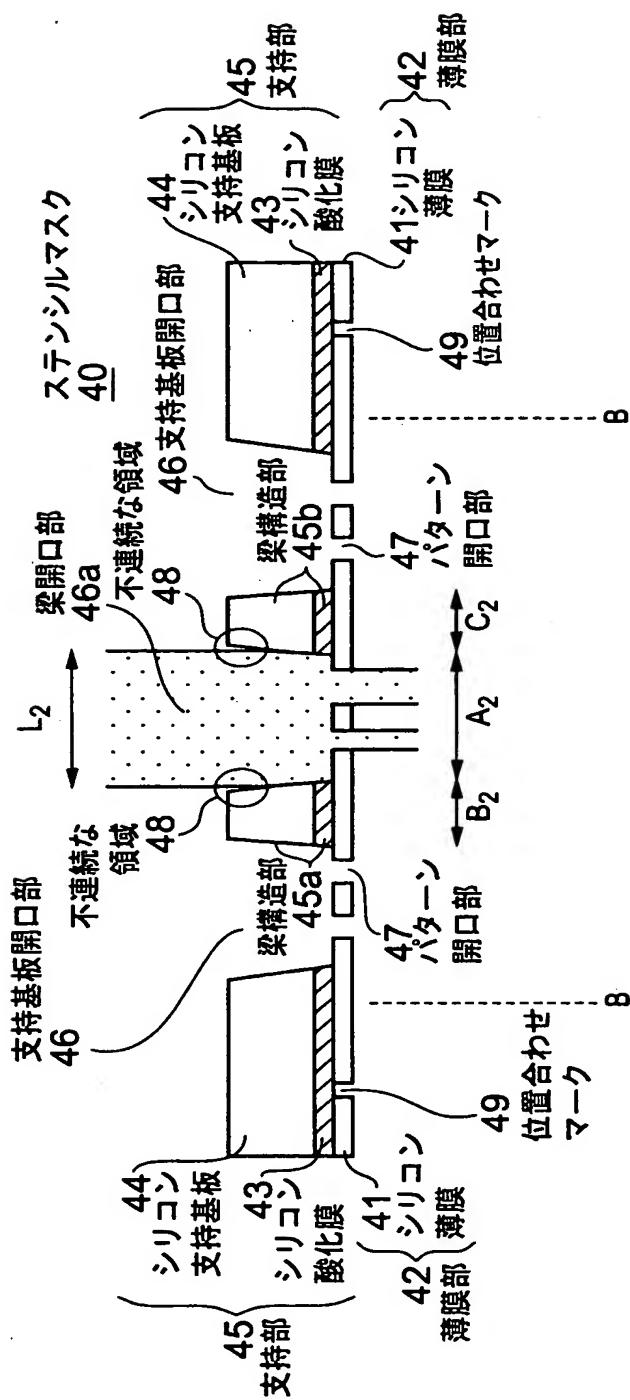
【図5】



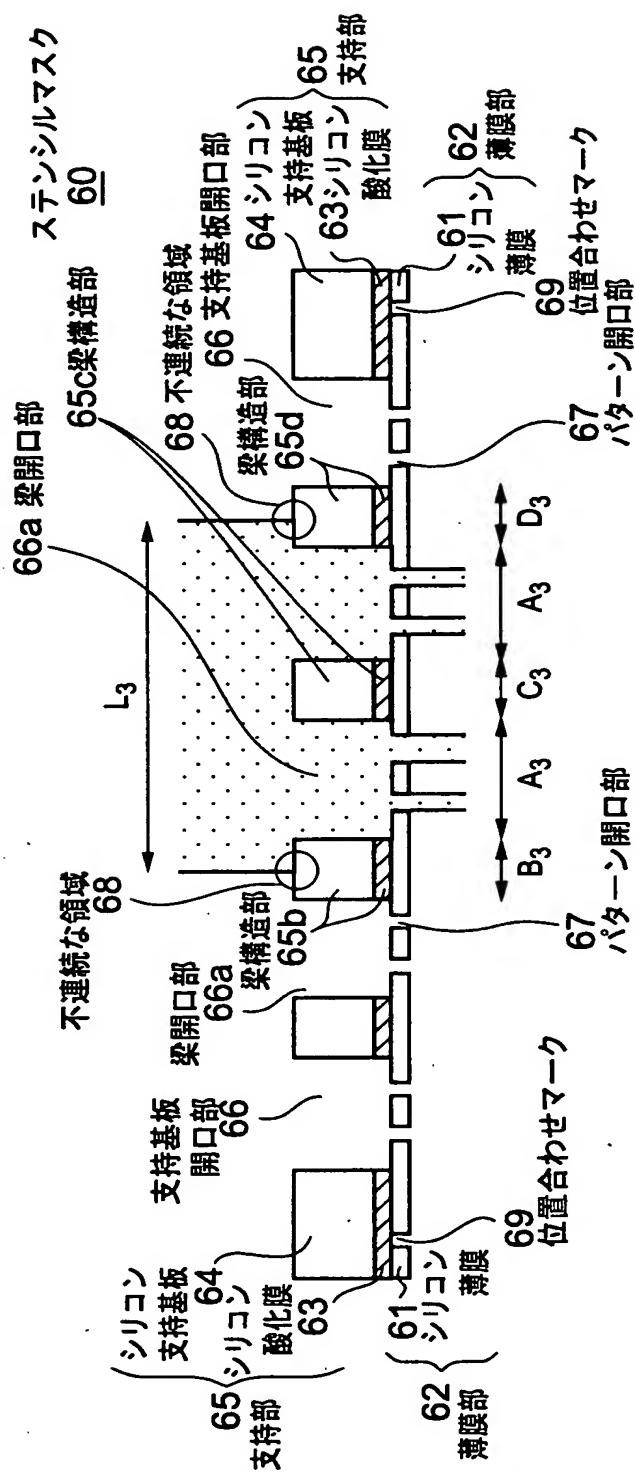
【図6】



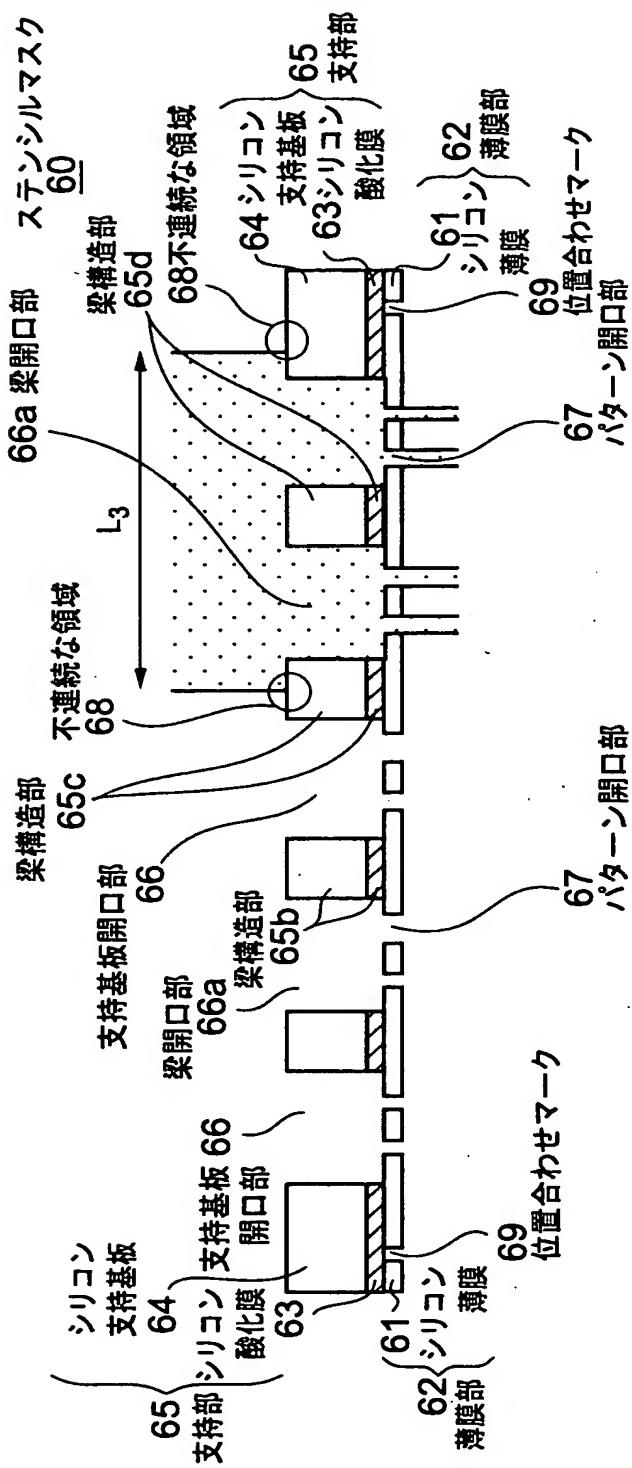
【図7】



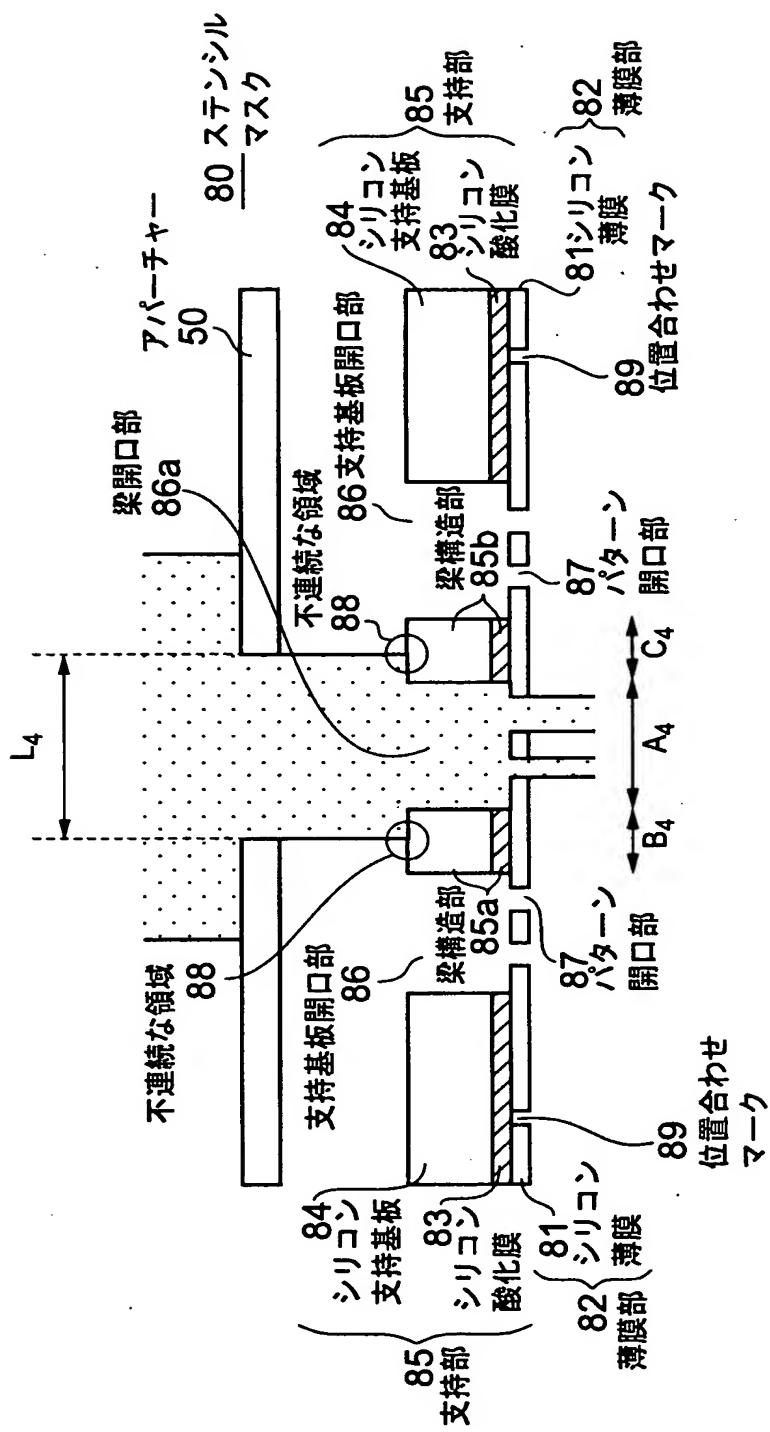
【図8】



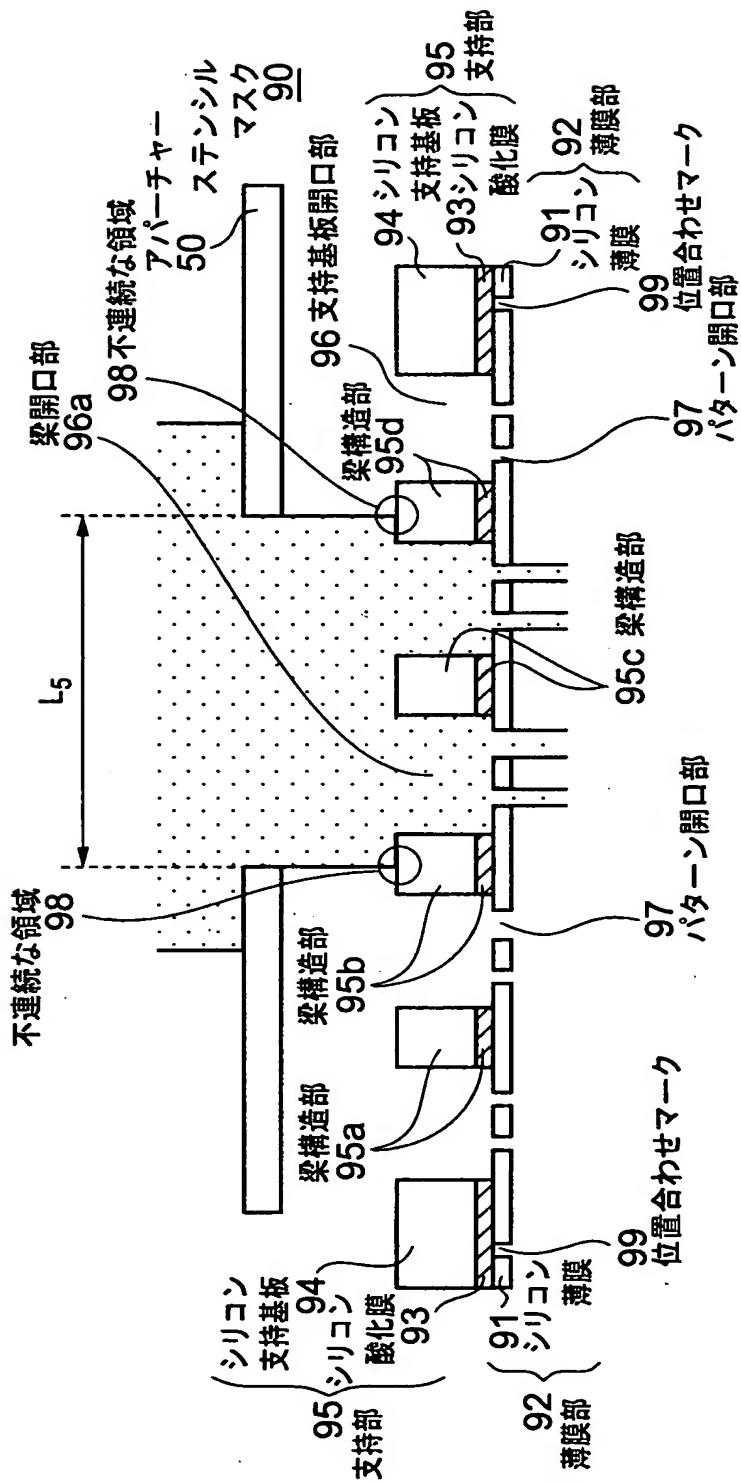
【図9】



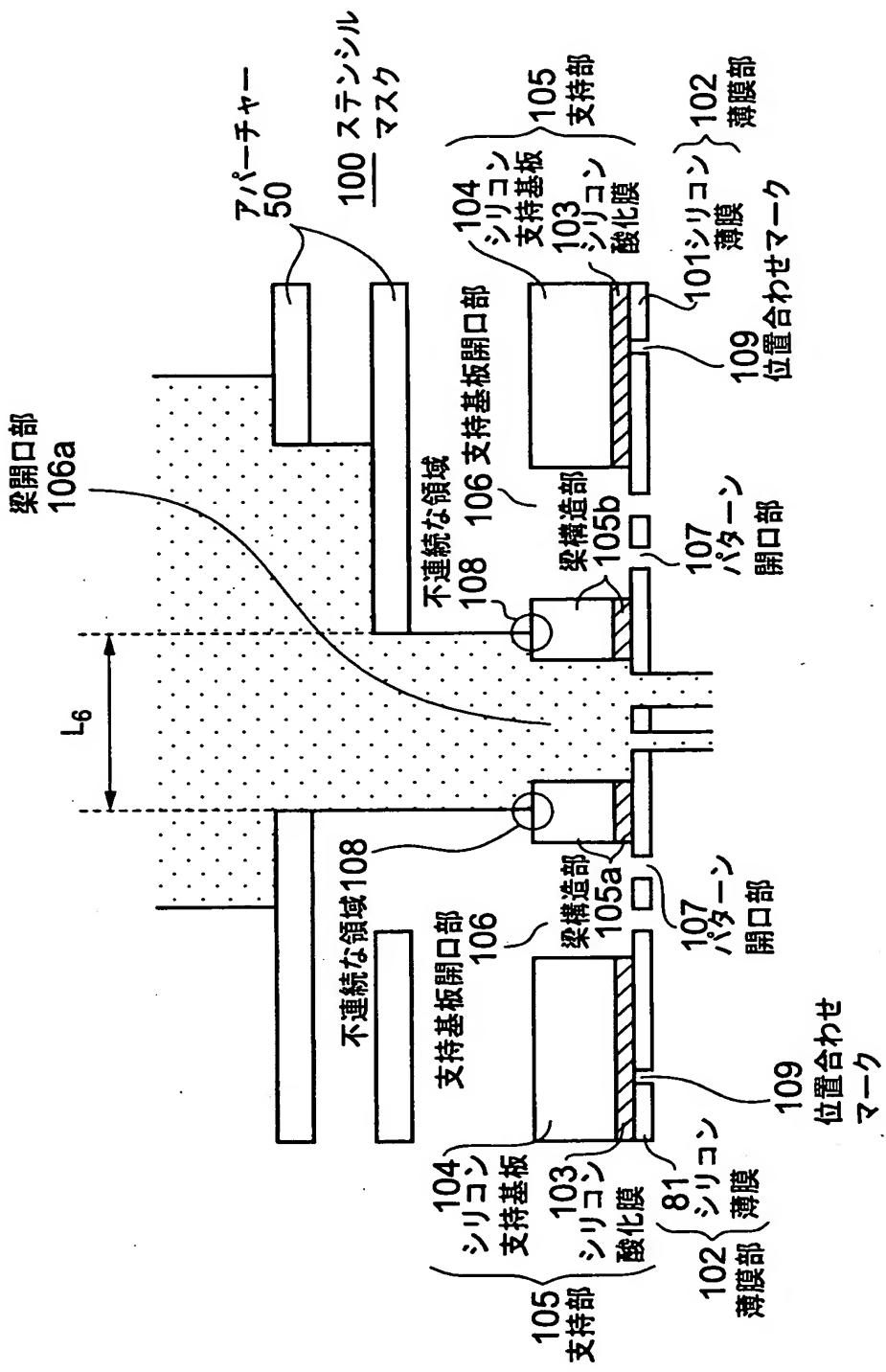
【図10】



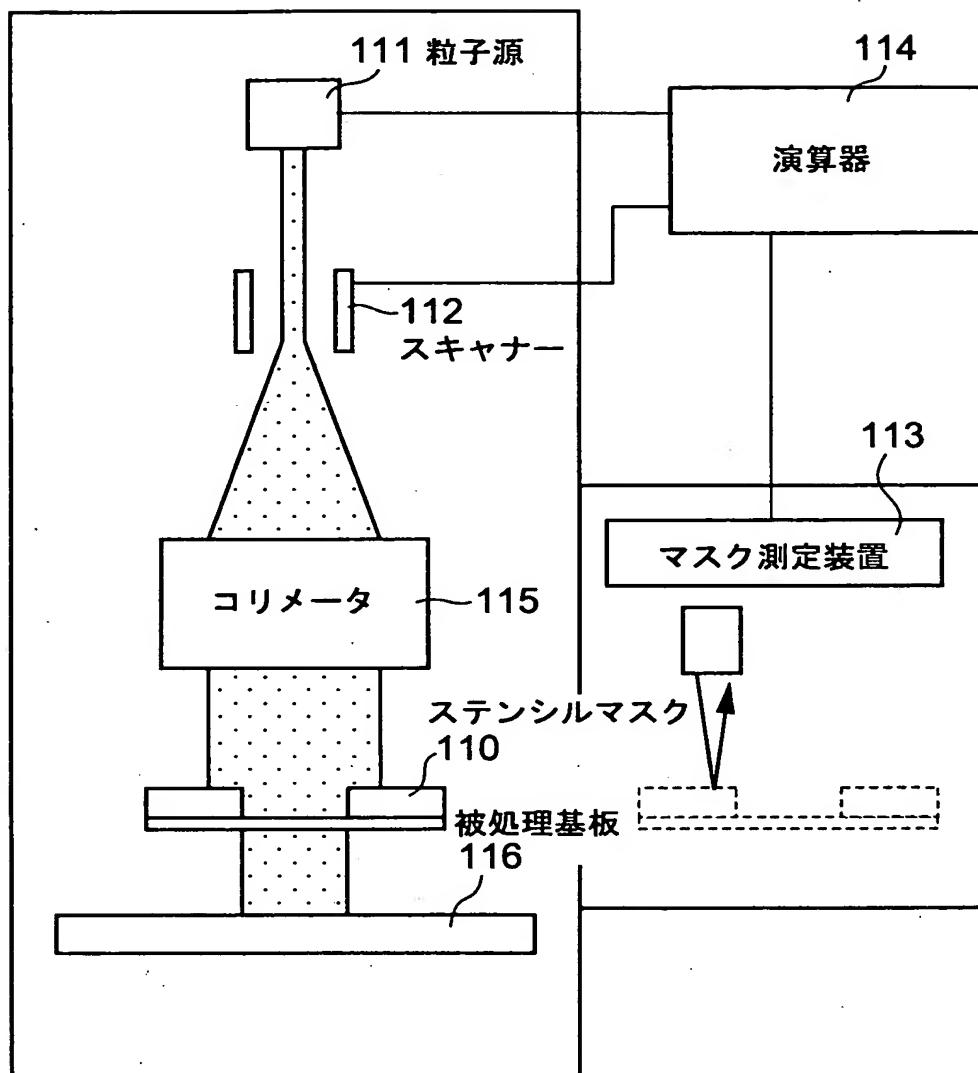
【図11】



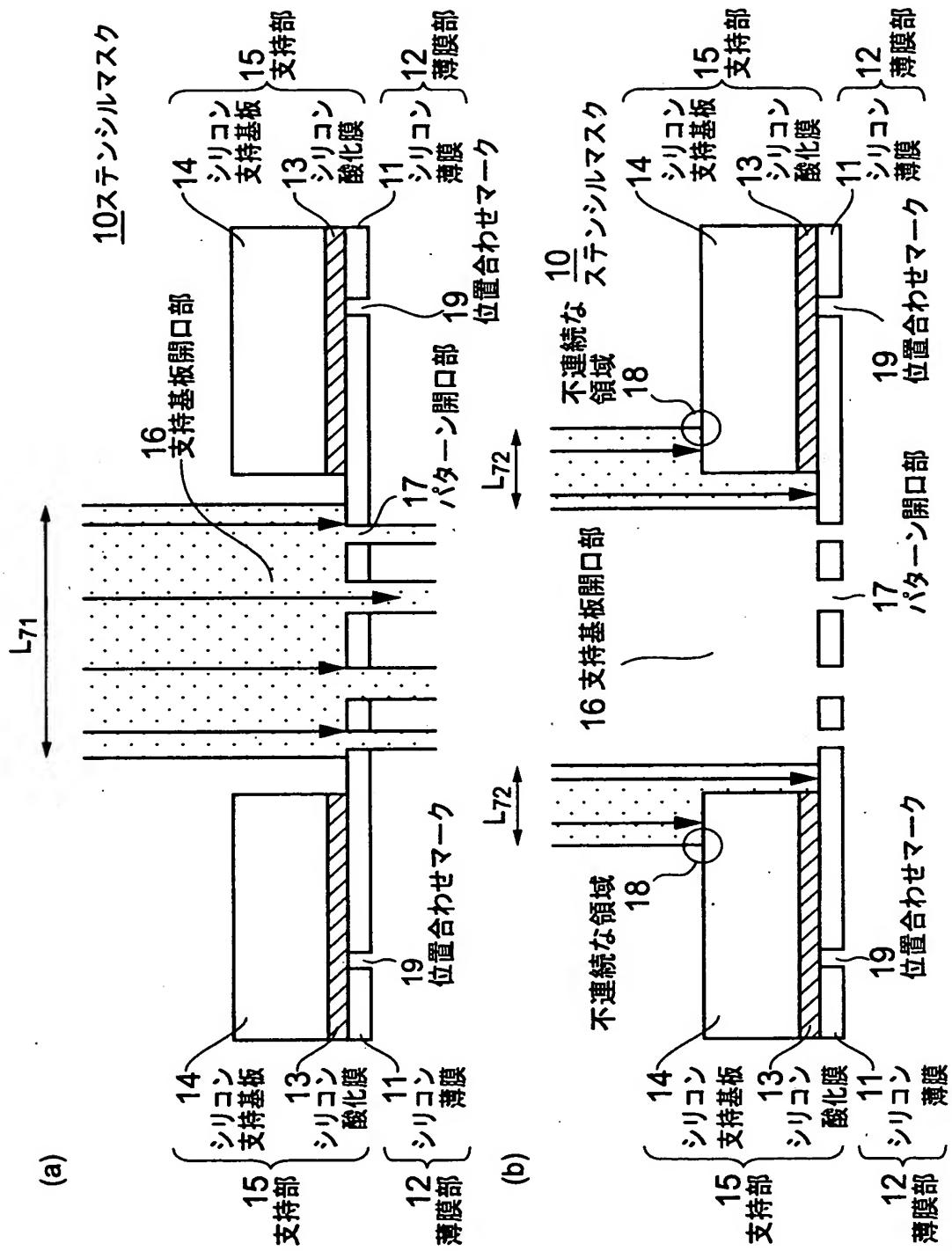
【図12】



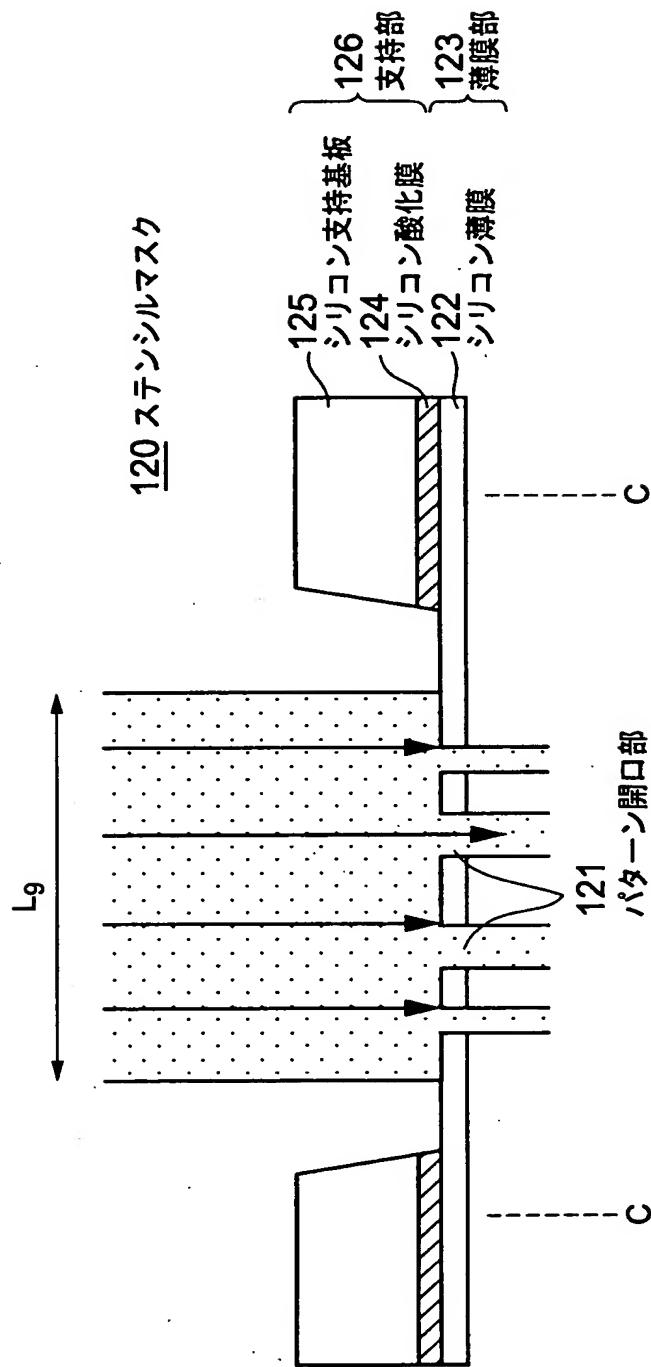
【図13】



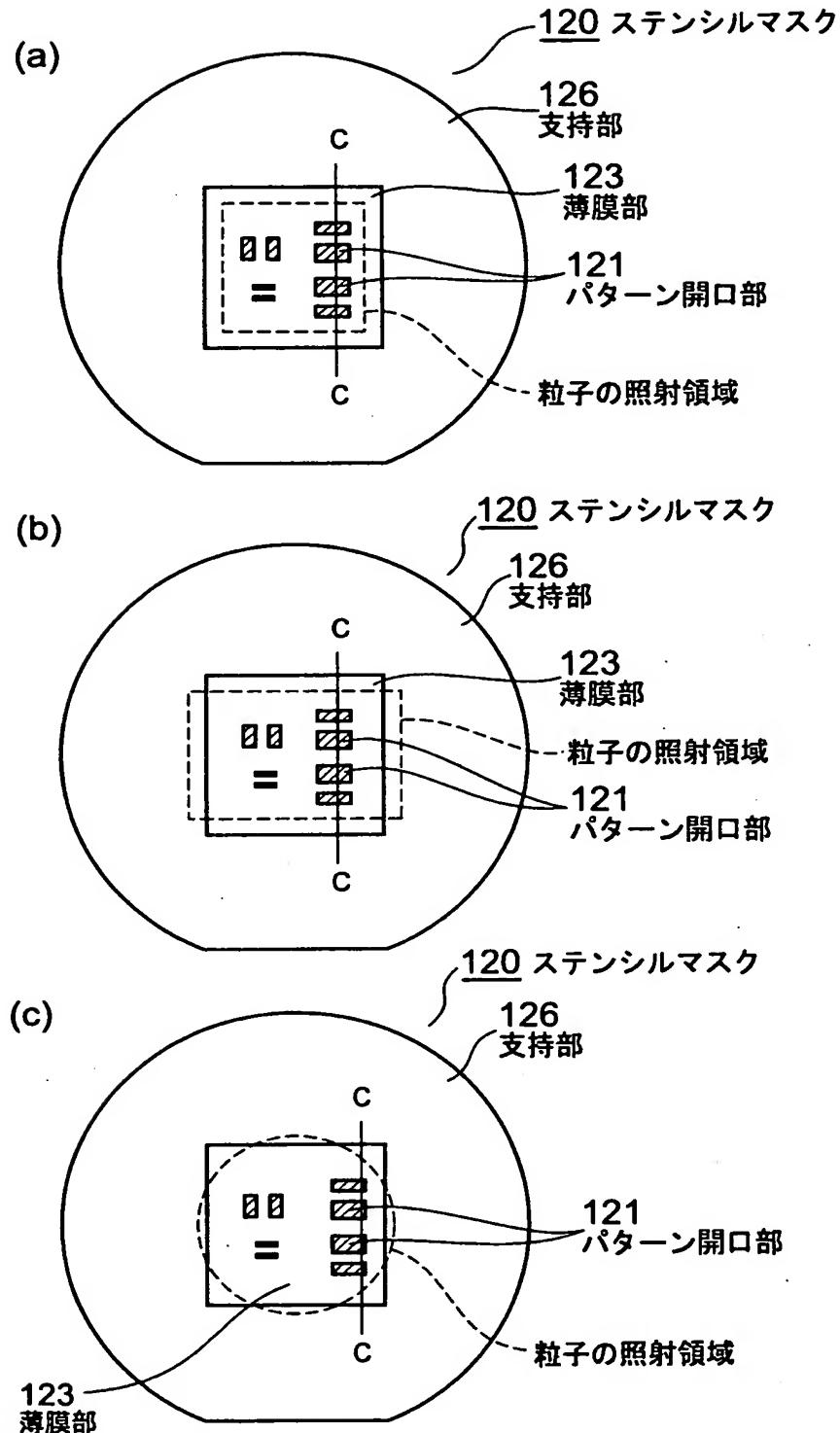
【図14】



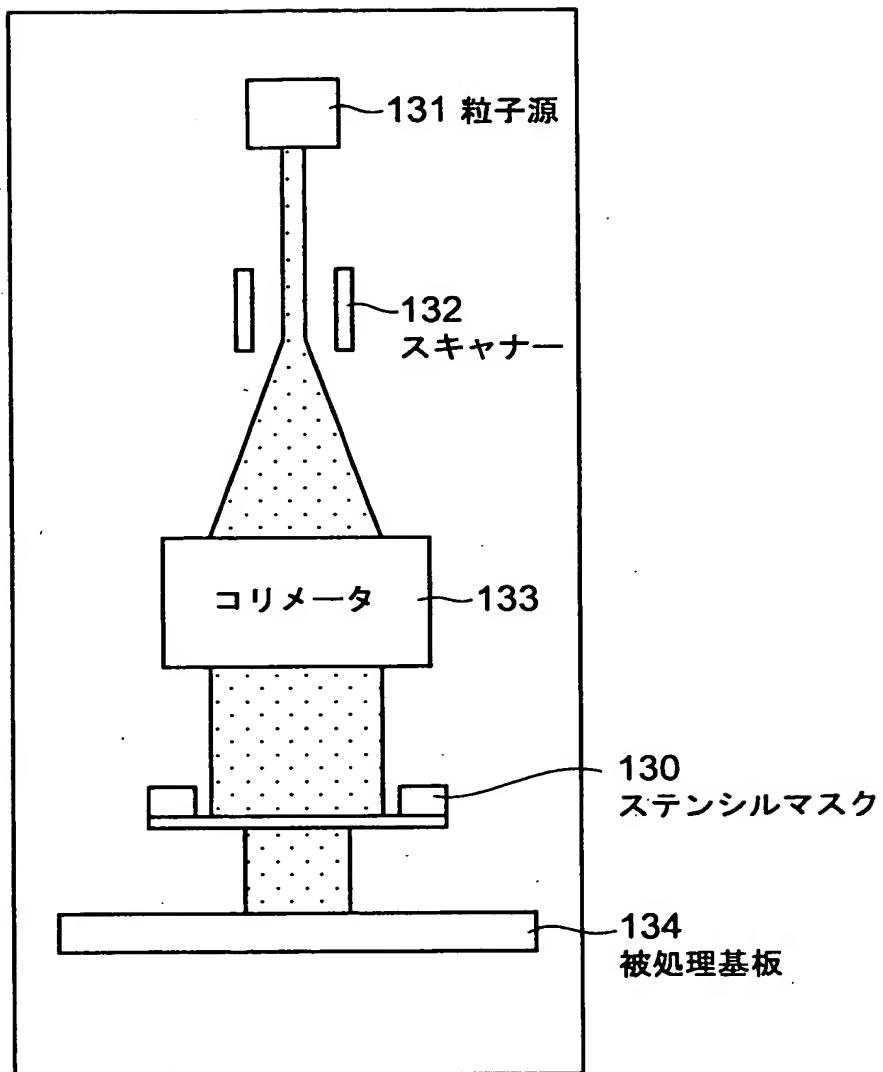
【図15】



【図16】

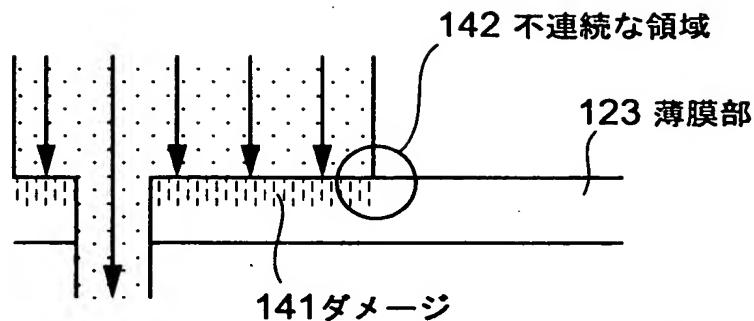


【図17】

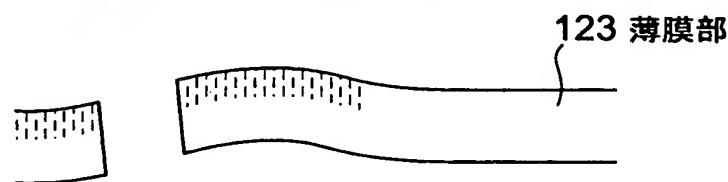


【図18】

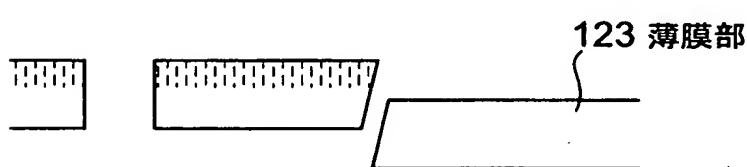
(a)



(b)



(c)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体製造工程において用いるステンシルマスクの変形、破損などの劣化を抑止することが可能となる半導体製造装置を提供する。

【解決手段】 薄膜部12及び前記薄膜部12を支持する支持部15を有するステンシルマスク10に粒子ビーム16を照射し、前記ステンシルマスク10の前記薄膜部12に形成された開口部17を介して、被処理基板に前記粒子ビーム16を照射する半導体製造装置において、前記ステンシルマスク10に照射される、前記粒子ビーム16の照射領域の端部が、前記ステンシルマスク10の前記薄膜部12上に存在しないよう、粒子ビームの照射領域を調整し、前記粒子ビーム16を照射することを特徴とする半導体装置の製造方法である。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-375978
受付番号	50201969692
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成15年 1月 6日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年12月26日

次頁無

出願人履歴情報

識別番号 [000003078]

1. 変更年月日 2001年 7月 2日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区芝浦一丁目1番1号
氏 名 株式会社東芝

2. 変更年月日 2003年 5月 9日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都港区芝浦一丁目1番1号
氏 名 株式会社東芝